水電解による水素製造・精製・水素キャリア合成を同時に行う革新的な水素透過金属膜電極装置の開発

宇都宮大学 工学部基盤工学科

佐藤 剛史

1. はじめに

水素エネルギー社会・分散化社会への移行が進行する中で、狭小地にて再生可能エネルギー 由来の電力で水素を製造し、常温で液体状態である水素キャリア(例:芳香族水素化化合物)とし て貯蔵する小型システムの構築が期待されている。このシステム構築のためには、コンパクト な水電解水素製造とそれに引き続く水素化反応を同時に可能とするデバイスが必要となる。

ところで、水素を選択的に透過する水素分離膜として、導電性を有する金属膜であるパラジ ウムー銀合金膜(Pd-Ag 膜)が知られている。図1に、本膜の水素透過機構を示す。水素分子が 高水素分圧側にて金属上に吸着し原子状に解離した後、水素原子が金属結晶格子内を拡散する ことで膜の反対側に透過する。膜の反対側では、水素原子が再結合して脱着することで、見掛 け上水素透過が進行する。水素以外の分子は解離できず透過できないため、本膜は高い水素選 択性を有する。



図 1. パラジウムー銀合金膜の水素透過機構

我々は、この Pd-Ag 膜を電極とした水電解を利用した水素キャリア製造プロセスの開発を 進めている。¹⁾⁻³⁾図2に、本プロセスの概略を示す。再生可能由来の電力を利用し、カソード 電極として Pd-Ag 膜を用いた電解槽にて水電解を行う。この時、カソードの膜電極表面にて水 素が発生することで水素製造が生じる。ここで生成した水素が原子状となり Pd-Ag 膜の結晶 格子内を透過することで選択的な水素透過が生じ、水素から酸素や水蒸気を除去する水素精製 が進行する。水素はそのまま用いることも可能であり、さらに膜の透過側に担持金属触媒層を 配置しトルエン水素化を行うことで、メチルシクロへキサン(水素キャリアの一種)の合成が 可能となる。すなわち、本装置にて水素製造・水素精製・水素化を一体化して行うことが可能 となり、これらを達成するためのコンパクトな装置の作成が可能となる。本プロセスは原理的 に可能であることが明らかとなっているものの、膜面積増大や電極間距離短縮など実用化を見 据えた装置改良や水素化条件の最適化が課題である。 本研究では、従来の装置の知見をもとに新たに Pd-Ag 膜電極による水電解を利用した水素 化装置を作製した。作製した装置を用いて水電解によるトルエン水素化を行い、水素化への温 度や水素供給量の影響を評価した。



図 2. Pd-Ag 膜電極による水電解を利用した水素キャリア製造プロセス

水電解水素製造・水素化装置の開発と実験方法

ここでは、今回開発した水電解水素製造・水素化等装置について説明する。図3に今回作製 した電解セルの断面図を、図4に電解セルと装置全体の写真を示す。セルはステンレス製であ り、図 4(b)に示すようなセル内の空間にテフロンブロックなどを配置することで所定の流路や 電極などを配置可能な構造としている。ここで、図 3(a)を参照して説明を進める。電解槽は 2.0 cm×2.0 cm×1.0 cm の空間であり、電極間距離は 1.0 cm となる。これは、従来型装置^{1),2)}と比較 して膜面積が5倍、電極間距離が約1/10に相当し、水電解がより容易に進行する構造となっ ている。カソードは Pd-Ag 膜電極(Pd75wt%-Ag25wt%で 0.1 mm 厚)であり、アノードは Pt メッ シュ(孔径 80 mesh)である。装置の構造上、溶液との接触面積が 20 mm 角であり、カソードと アノードに用いる材料はそれより少し大きい 25 mm 角規格とした。触媒は、市販の 5wt%Pt/Al2O3 触媒 0.075g を用いた。これをステンレスメッシュ(39 mesh)にて包み込むことで 触媒層とした。カソードに接触させる導線にはステンレス線(直径 1.0 mm)、アノード側に接 触させる導線には Ag 線(直径 0.4 mm)を用いた。 これらは絶縁のために接触部以外を PEEK チ ューブ(外径 1/16 inch)で被覆されている。アノードに関しては、導線に対する接触部分となる 先端を4mm程度露出させ、金メッキばねを介して電極と接触させることで通電を可能とした。 カソードについては、ステンレス線を触媒層と接触させ、触媒層のステンレスメッシュを介し て膜と接触させることで膜電極への通電を可能とした。

電解液供給のために、セル下部のカソードとアノード両側に各1ケ所、溶液排出部としてセ ル上部のカソードとアノードの各1ケ所の計4か所に孔を設けた。セル下部の孔から電解液 である水酸化カリウム溶液を供給した。電解液はおもに電極近傍を通過する構造となってお り、電極表面に気泡が発生した場合に速やかに排出できるようになっている。Pd-Ag 膜を介し た電解部の反対側には、キャリアガスである窒素と窒素バブリングによりトルエンを供給し た。供給した窒素やトルエンは、触媒層を通過した後に膜を透過した水素や生成した水素化物 を同伴しセル外へと排出された。



図 3. 電解セルの断面図(a:縦断面、b:横断面)



図 4. 電解セル、装置全体の写真(a:電解セル縦断面、b:電解セル内部、c:装置全体)

図5に、水電解水素化装置装置全体の構造を示す。なお、装置全体の写真は図4(c)に示した 通りである。電解セルを反応温度に設定したGCオーブン内に設置することによって、セルの 温度制御を行った。0.5 mol/L水酸化カリウム水溶液は、HPLCポンプを用いて電解セル下部か ら1.0 g/minにて電解側に供給した。窒素はマスフローコントローラーによって供給し、所定 温度に制御したトルエン液体内を通過させることでトルエンを同伴した状態にて膜の透過側 に供給した。未透過水素と酸素は水酸化カリウム水溶液とともに背圧弁を経て、透過水素は窒 素とともに装置外部へ排出された。電解側圧力について、今回は背圧弁を全開として常圧で制 御した。また、直流電源にて、アノード・カソード間に所定の電圧を印加し、デジタルマルチ メーターにて電流値を継続的に測定した。印加電圧は通常2.0 Vとした。電解側・透過側から 排出された気体中の水素・酸素について、水上置換法によりプラスチック製メスシリンダーに 回収しその流量を測定し、ガスの一部をサンプリングして GC-TCD にて定性・定量を行った。 また、液体生成物はベンジルアルコールトラップにて補足した後、GC-FID にて定性・定量した。



図 5. 水電解水素化装置全体の構造

3. 水電解水素製造・水素化装置による水素キャリア合成

まず、水素製造に関する温度の影響について説明する。図6に、電流値、水素透過率、透過 水素量と温度の関係を示す。ここで、水素透過率は、生成した水素に対して膜を透過した水素 の割合で定義した。温度上昇により電流値が増大していた。これは、通常の水電解と同様、温 度上昇により水の粘度が低下し膜近傍への物質移動が促進されたためである。水素透過率は、 常に 90%以上であり、水電解で発生した水素のほとんどが膜を透過して水素化での利用が可 能な状態であった。今回の装置では膜の透過側にキャリアガスとして窒素を供給しているた め、膜の透過側の水素が速やかに膜近傍から移動することで、透過側の水素分圧が低下するこ とで水素の膜透過が促進されていた。水素透過率が温度上昇によりさらに上昇したのは、温度 上昇により水素透過係数が増大する膜の特性によるものである。⁴⁾ 透過水素流量はこれらの要 因により温度上昇により増大していた。

次に、トルエン水素化の結果について説明する。図7に、トルエン転化率、供給水素過剰率、 水素利用率と温度の関係を示す。液体生成物はメチルシクロヘキサンのみであった。トルエン の水素化物であるメチルシクロヘキサンが生成したことから、本装置により水電解由来の水素 を利用した水素キャリア合成が可能であることが明らかとなった。トルエン転化率は40 ℃で 18%であり、温度上昇により増大し95 ℃にて86%になった。これは、温度上昇による水素透 過量の増大と反応速度の増大によるものと考える。ここで、供給水素過剰率を、供給水素過剰 率 = 透過水素量[mol/s] / (トルエン供給量[mol/s]×3)にて定義し、水素化に必要な水素量に対 して反応場に供給した水素量として表す。ここでの検討では、供給水素過剰率が1 以下であ り、トルエン全体の水素化に必要な水素量以下での反応であることがわかる。また、水素利用 率を、水素利用率 = (水素化に利用された水素量[mol/s]/透過水素量 [mol/s])×100 にて定義し、 反応場に供給した水素のうちどの程度が水素化反応に用いられているかを表す。水素利用率 は、温度上昇により 20%から上昇し最大 80%程度となった。未利用の水素が存在することか ら、触媒とトルエンの接触に課題があると考えている。



図 6. 電流値、水素透過率、透過水素量と温度の関係(95 ℃,窒素流量 0.5 cm³/min, ●:電流値、▲:水素透過率、■:透過水素流量)



図 7. トルエン転化率、供給水素過剰率、水素利用率と温度の関係(95 ℃,窒素流量 0.5 cm³/min, •:トルエン転化率, ▲:水素利用率, ■:供給水素過剰率)

ここで、95℃にて窒素流量を操作してトルエン供給量を変化させた実験を行った。図8に、 トルエン転化率、供給水素過剰率、水素化速度と接触時間の関係を示す。ここで、接触時間[(kg・ s)/mol]は、触媒量[kg]をトルエン供給量[mol/s]で除したものであり、供給したトルエンと触媒 がどの程度接しているかの指標である。接触時間が増大することでトルエン転化率も増大し、 W/F=4000 (kg・s)/mol付近にて 90%以上となった。図7で説明した窒素流量 0.5 cm³/minは、 W/F=824[(kg・s)/mol]に相当する。この条件よりも窒素流量を低下させてトルエン供給量を減 少させ接触時間を増大させることで、見掛け上の反応が進行していた。低いトルエン供給量で は、供給したトルエンのほぼ全てをメチルシクロヘキサンに転換可能であることがわかった。 供給水素過剰率は接触時間の増大により 0.7 から 2.5 に増大しており、反応時間の増大に加え て供給水素量の増大も長い接触時間にて反応が促進された要因と考える。水素化速度は接触時 間の減少により減少し、トルエン供給量が全体の反応量に大きく関係していることがわかっ た。



図 8. トルエン転化率、供給水素過剰率、水素化速度と接触時間の関係(95 ℃,●:トルエン転 化率,▲:供給水素過剰率,■:水素化速度)

さらに、95 ℃にて電圧を1.7~3.0 Vの間で操作し、トルエン供給量はそのままに発生水素 量を操作し供給水素量を変化させることで供給水素過剰率を変化させる実験を行った。図9 に、トルエン転化率、電流値と供給水素過剰率の関係を示す。供給水素過剰率の増大により 電流値が増大している。これは、電圧を増大させると電流値が増大し水素発生が促進される ため、最終的に膜の透過側に供給される水素量も増大したためである。本条件下にて供給水 素過剰率は 0.43 から 1.80 まで増大した。トルエン転化率は供給水素過剰率の増大により増大 し、供給水素過剰率 1.6 付近でほぼ 100%近くになった。これは、トルエン水素化を進行させ るのに水素供給量の増大が有効であることを示している。さらに、現装置にてトルエン水素 化を完全に進めるには、化学両論比よりも少し多めの水素供給量が必要であることを示して いる。トルエンと水素の接触過程を効率化することで、所定のトルエン転化率に必要な供給 水素過剰率を低下させることが可能と考える。



図 9. トルエン転化率、電流値と供給水素過剰率の関係(95 ℃,●:トルエン転化率,▲:電流値)

4. まとめ

本研究では、水電解による水素製造・水素精製・水素化による水素キャリア合成を同時に 達成可能なシステム開発のために、パラジウムー銀膜を電極とした水電解水素化装置を作製 した。作製した装置を用いて水電解によるトルエン水素化を行った結果、本装置にて水電解 により生成した水素の90%以上が膜を透過し、トルエン水素化によるメチルシクロへキサン 合成が選択的に進行し、トルエン条件によってはほぼ全てのトルエンが反応することを確認 した。さらに、トルエンに対する水素供給量の増大がトルエン転化率増大に有効であること を明らかとした。

謝辞

本研究を遂行するにあたり、(公財)天野工業技術研究所から多大なご支援を頂きました。こ こに記して謝意を示します。

参考文献

- 佐藤剛史,島村雛季,伊藤直次,"水素透過パラジウム膜を電極とした加圧水電解における水素 製造・分離と水素化反応への応用"高圧力の科学と技術,31,32-40,(2021).
- 2) T. Sato, A. Takad and N. Itoh, "Low-temperature hydrogenation of toluene by electrolysis of water with hydrogen permeable palladium membrane electrode," Chem. Lett., 46,.477-480 (2017).
- 3) T. Sato, S. Sato and N. Itoh, "Using a hydrogen-permeable palladium membrane electrode to produce hydrogen from water and hydrogenate toluene," Int. J. Hydrogen Energy, 41,.5419-5427 (2016).

4) E. Serra, M. Kemali, A. Perujo and D.K. Ross, "Hydrogen and deuterium in Pd-25 pct Ag alloy: Permeation, diffusion, solubilization, and surface reaction," Metall. Mat. Trans. A, 29, 1023-1028 (1998).